

采用超微型 DFN0.6X0.6 封装并配备散热焊盘 高效能 20V N 通道 MOSFET 实现卓越散热与空间节省!

美国加州圣荷西，2026 年 4 月 30 日 —Analog Power 今日发表高效率 20V N 通道功率 MOSFET AMPMH600UNE。此元件采用超紧凑 DFN0.6x0.6-3EP 封装，具备 600mΩ 典型 RDS(on)；藉由创新的散热焊盘 (Exposed Pad) 设计，能在极微小的电路板空间内展现卓越的散热潜能，为空间受限及电池供电的电子产品提供高度可靠、低电阻的切换解决方案。

AMPMH600UNE 通过在业界标准微型封装中整合 20V 耐压与散热焊盘，成功协助设计人员在兼顾优异热管理的同时，大幅释放电路板布局弹性。此技术突破不仅显著简化了高密度电路设计，更比传统大型封装替代方案大幅缩减了电源路由与负载切换所需的整体占地面积。

本元件的主要特色包括：

- 20V N 通道功率 MOSFET，实现高效的低电压电源调节
- 典型 RDS(on) = 600mΩ，有效降低导通损耗并最大化提升整体系统效率
- 搭载散热焊盘的超微型 DFN0.6X0.6-3EP 封装，兼顾散热与高效布局
- 低临界电压 (Low threshold voltage)，完美适用于直接逻辑电平栅极驱动
- 坚固的半导体设计，在严苛的高密度环境下提供高可靠度与长期稳定性

典型应用：

- 超轻薄便携式电子产品 (如手机、穿戴装置) 的高侧负载切换
- 电池管理系统 (BMS) 与手持式装置的电源路由
- 高效率、低剖面 (low-profile) 的 DC/DC 转换模块
- 讯号闸控与小讯号切换电路
- 空间受限的 IoT 传感器与嵌入式硬体



Analog Power 的 600mΩ、20V DFN0.6X0.6-3EP 封装 N 通道 MOSFET 现已开放样品申请，并支援量产供货。产品数据资料表请至下列网址下载：

<https://www.analogpowerinc.com/datasheet.php?part=AMPMH600UNE>

如需更多资讯，请造访：www.analogpowerinc.com。

关于 Analog Power：Analog Power 成立于 2002 年，总部位于美国加州圣何塞，是功率 MOSFET 的领先制造商。公司提供完整的 N 信道与 P 信道 MOSFET 产品线，电压范围覆盖 20V 至 1.5kV，并提供面向特定应用的 MOSFET，助力终端产品小型化并提升性能。依托与一流晶圆代工厂及封装测试外包伙伴的合作，Analog Power 在保持行业领先的质量与可靠性的同时，仍坚持灵活、高度以客户需求为导向的服务理念。



联系信息

Analog Power Inc

台北市内湖区洲子街 58 号 1 楼A7

邮政编码: 114064

<https://www.analogpowerinc.com/contactus.html>